

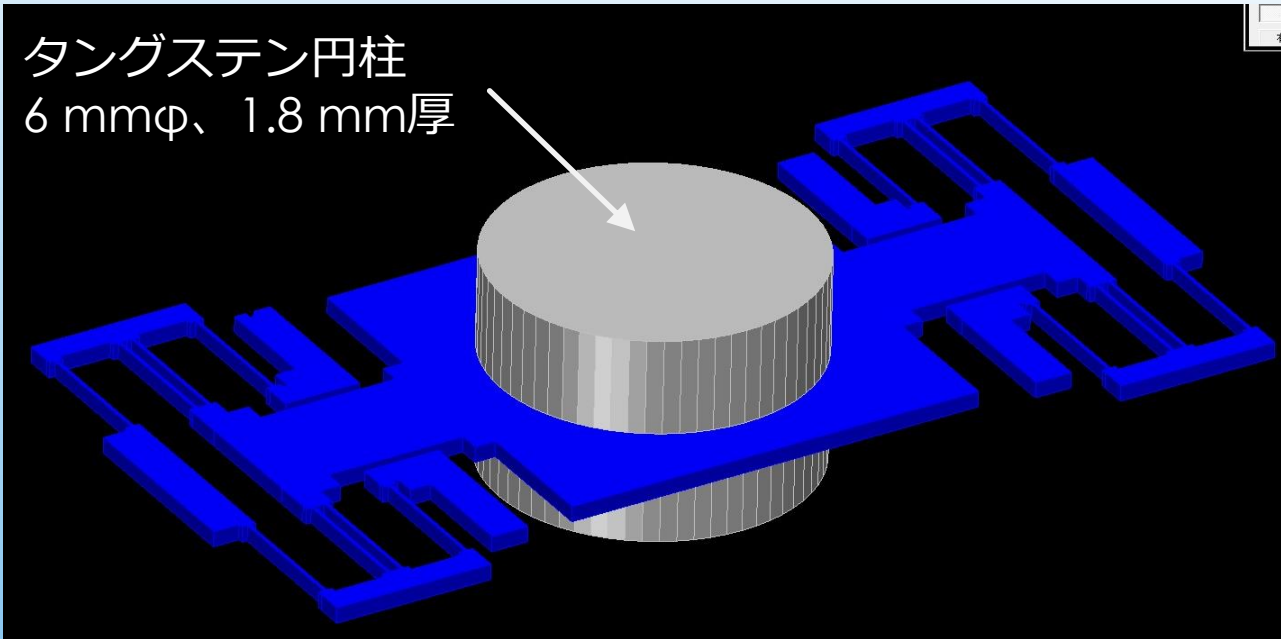
MEH研究会 5月

静岡大学



構造シミュレーション

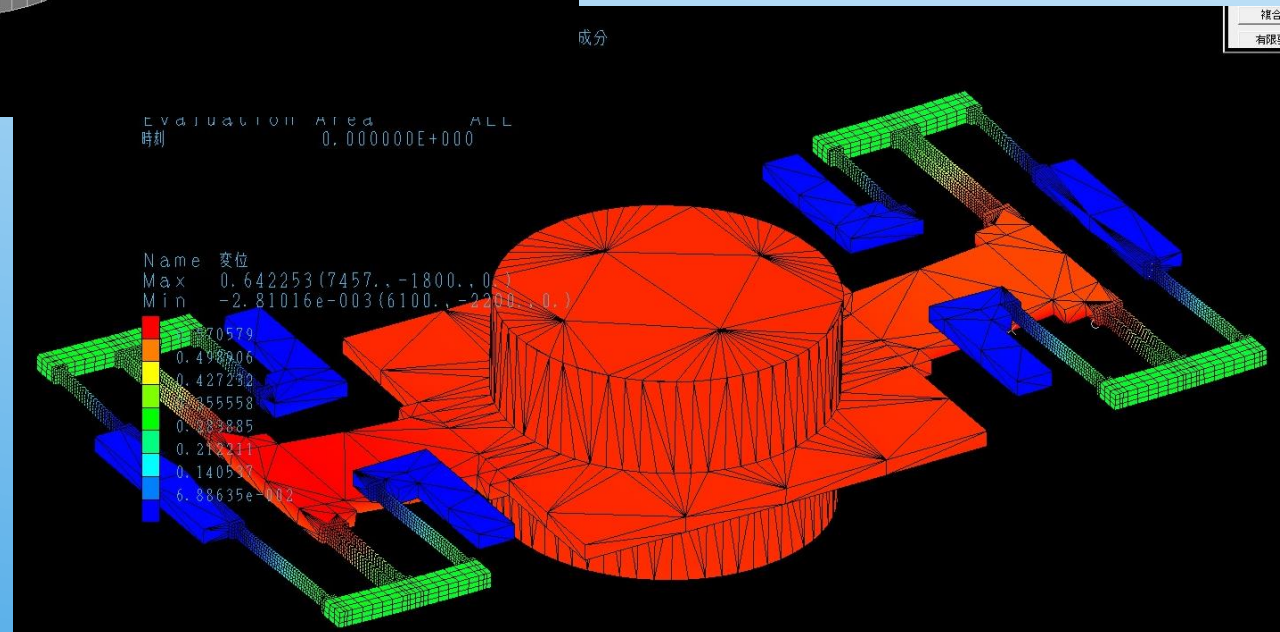
タングステン円柱
6 mmφ、1.8 mm厚



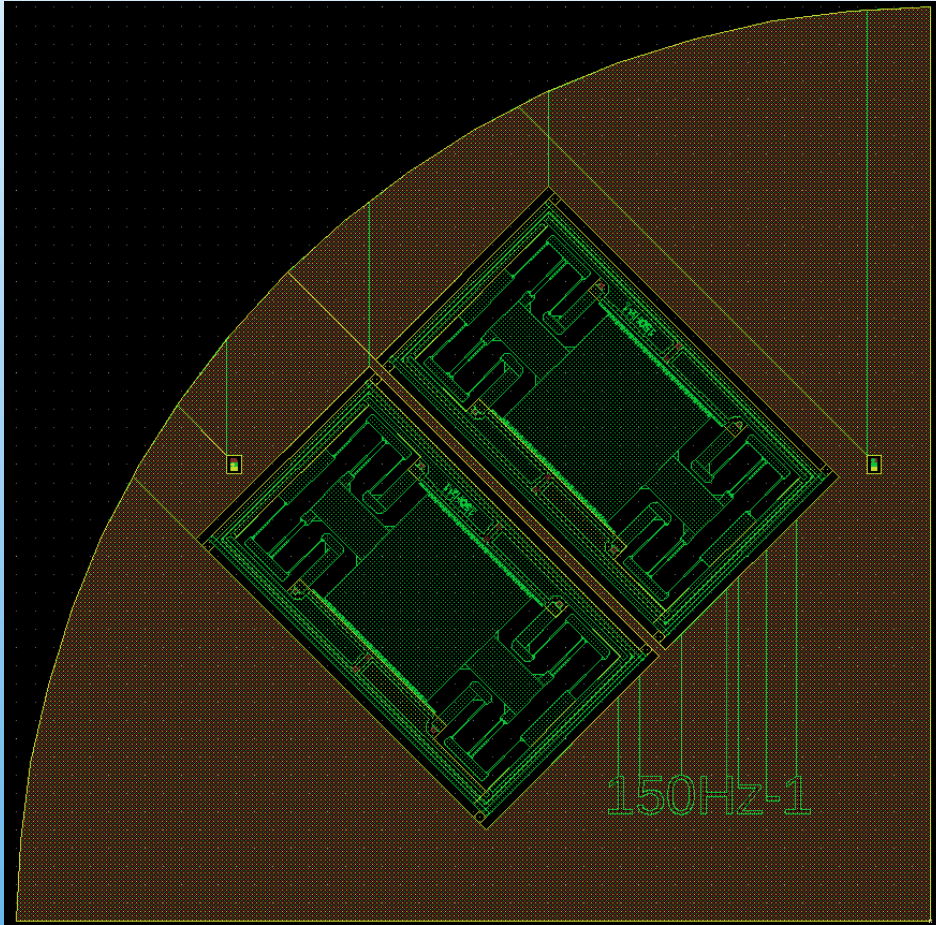
デバイス層 300 μm のSOI使用

1GによるZ方向変位：約1 μm

想定加速度によるX方向変位
とY方向安定性を確認



Crマスクデータ作成

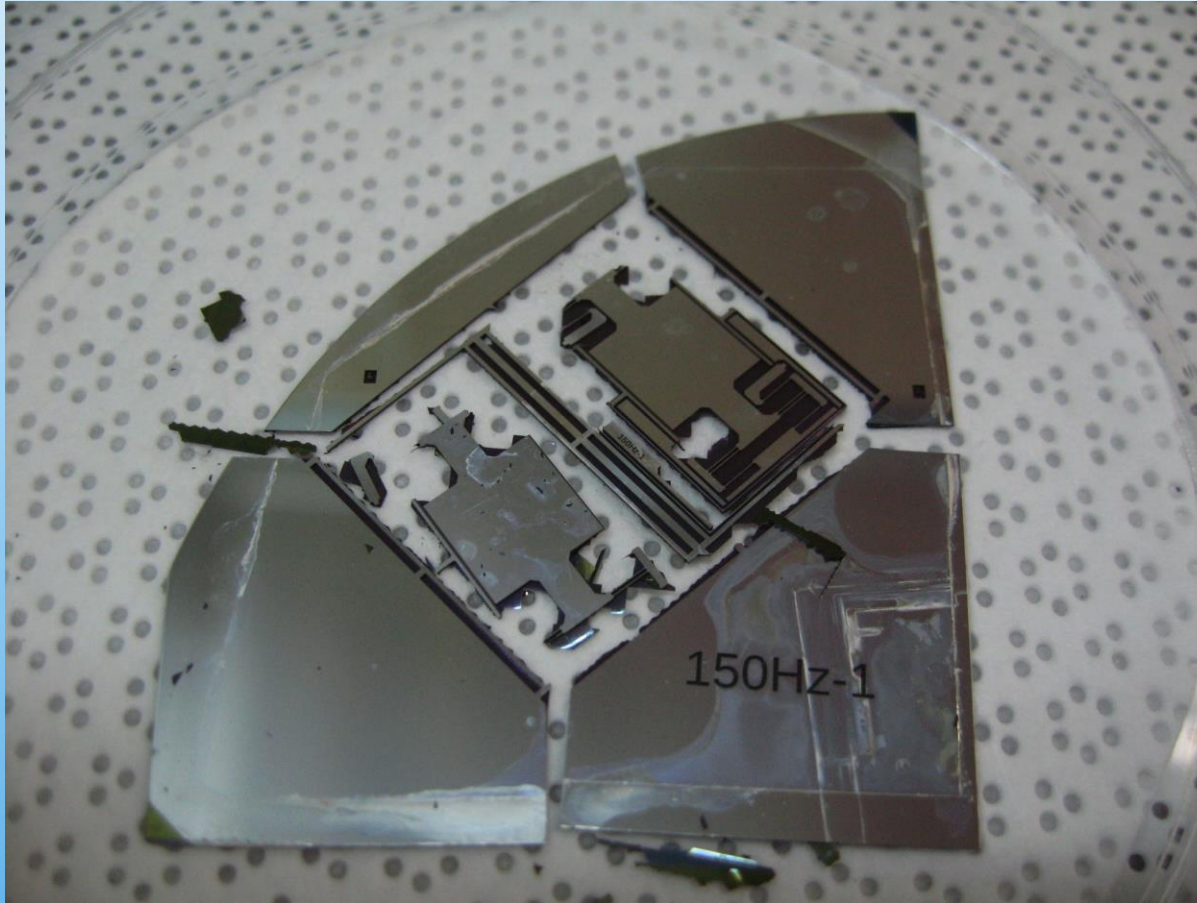


周波数：150Hz、300Hz

電極間隔：1:1、1:2

マスク発注済み

作製失敗



SOIウェハ：300/1/8

ICPエッチング中に
ヒビが入る

300/2/500 ウェハ
発注